

Germanium PNP Transistor

GD175

50V / 3A

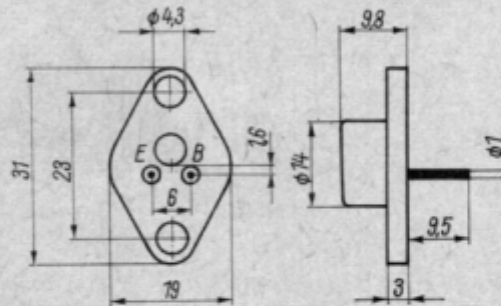
DATASHEET

OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72

GD 175, 2-GD 175

Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11 811 für 48-V-Schalteranwendungen, für Niederfrequenz-Leistungsverstärker und als Pärchen in Gegentaktendstufen bei Spitzenspannungen bis zu 50 V.



Masse ca. 12 g

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 50 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	= 48 V
$R_{EE} = 50 \Omega$		
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES}$	= 50 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 10 V
Gesamtverlustleistung	P_{VL}	= 5,3 W
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 3,0 A
Emitterstrom	I_{EL}	= 3,6 A
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 0,6 A
Sperrschichttemperatur	ϑ_{jL}	= +75 °C
Umgebungstemperatur	ϑ_{aL}	= -25 °C bis +65 °C
Wärmewiderstand	R_{thjc}	$\leq 7,5 \text{ grad/W}$

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus



RFT electronic		GD 175, 2-GD 175		
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 6\text{ V}$	$-I_{CBO}$		20 μA	50 μA
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 48\text{ V}$	$-I_{CES}$		300 μA	1000 μA
Emitter-Basis-Reststrom $-U_{EB} = 10\text{ V}$	$-I_{EBO}$		60 μA	100 μA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $-I_B = 0,5\text{ A}$ $-I_C = 3\text{ A}$	$-U_{CEsat}$		0,3 V	0,6 V
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,2\text{ A}$	$-U_{BE}$		0,35 V	0,5 V
Basis-Emitter-Spannung $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 1,5\text{ A}$	$-U_{BE}$		0,75 V	1,0 V
Dynamische Kennwerte				
Übergangsfrequenz $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,1\text{ A}$	f_T		250 kHz	
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 1,5\text{ A}$	h_{21E}		18	35
			28	56
			45	90
$-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 1,5\text{ A}$	h_{21E}		30	
h_{21E} -Verhältnis $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 1,5\text{ A}$ $-I_C = 0,2\text{ A}$	$\frac{h_{21E 1,5}}{h_{21E 0,5}}$		0,5	
				Stromverstärkungsgruppe
				A
				B
				C




KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus

115

GD 175, 2-GD 175		RFT electronic		
Pärchenbedingungen		Min.	Typ	Max.
I_{B1} : $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,2\text{ A}$	I_{B1}			
	I_{B2}	0,833		1,2
I_{B2} : $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $-I_C = 3\text{ A}$	U_{BE1}			
	U_{BE2}	0,833		1,2
$-U_{CE} = 2\text{ V}$				
$-I_C = 3\text{ A}$				

Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe A	Transistor GD 175 A
Bestellbeispiel für ein Transistorpaar der Stromverstärkungsgruppe A	Transistorpaar 2-GD 175 A

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) Röhrenwerk Anna Seghers Neuhaus	
---	---

